

Intel : pas de plate-forme Atom avec modem LTE avant 2014

L'absence de modem LTE dans la plate-forme **Atom Medfield** est une lacune qu'Intel cherche à compenser. **Paul Otellini** a annoncé que les futurs SoC Atom qui supporteront la 4G LTE seront disponibles en 2014.

Pour appuyer ses dires, le PDG d'Intel a profité d'une conférence téléphonique avec des analystes durant laquelle l'essentiel de la conversation portait sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2012.

Il a en effet glissé au cours des discussions : « *En termes de solutions intégrées, vous verrez des niveaux plus élevés d'intégration de notre part l'année prochaine.* »

Il a ensuite précisé que les premiers téléphones équipés de processeurs Intel avec support de la 4G LTE seraient lancés début 2014, probablement lors du Mobile World Congress (MWC) 2014.

L'intégration du modem LTE est incontournable

Pour l'heure, Intel a une offre de modem LTE pour les données sous forme de circuit intégré. Au cours de l'année 2013, la firme de Santa Clara livrera également un modem multimode avec support des données via le LTE et de la voix via IP (VOLTE pour *Voice Over LTE*).

Intel capitalise sur le savoir-faire des équipes de l'ancienne *business unit* d'Infineon Technologies acquise en janvier 2013. À ce sujet, Otellini n'a pas tari d'éloges au sujet du travail effectué : « *Nous croyons que nous avons une solution très compétitive. L'équipe Infineon est connue pour ne pas être nécessairement la première à commercialiser, mais pour être vraiment bonne dans le façonnage d'une solution très robuste et rentable et compétitive en termes de coûts, et je pense qu'ils font un très bon travail en ce qui concerne ce produit.* »

La présence du modem LTE est un atout majeur pour les constructeurs de SoC. Il est impératif et impérieux pour rester dans la course à l'intégration. Qualcomm a déjà une offre de SoC Snapdragon intégrant le modem LTE. C'est aussi le cas de la société japonaise Renesas Mobile avec son SoC MP6530 et de ST-Ericsson avec sa plate-forme NovaThor L8580 gravée dans la technologie 28 nm FDSOI de STMicroelectronics.